|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.半导体分析仪主机一套：可以同步查看电流电压(I-V)、电容电压(C-V)，系统配置包含：一台主机+两个源测量单元 +电容电压测试单元一个+测试夹具盒一个；2.半导体分析仪系统主机具备计算机配置： CPU主频≥2GHz，硬盘容量≥120GB,带刻录CD驱动器，4个以上USB接口，内置100/10 MB以太网络接口，12英寸以上液晶显示器, Windows 操作系统，可以外接显示器；3.系统扩展性：半导体分析系统后面板具有不少于9个基于PCI总线的插槽，用于插入核心测量部件—SMU，插槽的设计采用竖型插入方式，这样可以最大程度地进行系统散热；4.电压源输出：≥210V；5.电压源设定分辨率：≦5μV；6.电流输出：≥100mA；7.电流源设定分辨率：≦1.5fA；8.电压测量范围：1μV-200V；9.电流测量范围：≥100mA；10.电流测量分辨率：≦0.01fA（需提供彩页，官网截图等佐证资料）；11.电流测量精度：≦10fA（需提供彩页，官网截图等佐证资料）；12.电容电压单元测量频率范围：1KHz-10MHz变频（需提供彩页，官网截图等佐证资料）；13. C-V测量偏置电压：≥ 60V（需提供彩页，官网截图等佐证资料）；14.提供样板测量例程，包括但不限于：MOSFET，双极器件，晶体管器件，晶体管电容器，电阻器，二极管； 15.电容测量单元可测试参数（包括但不限于）：Cp-G, Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cs-Rs, Cs-D, Cs-Q, Lp-G, Lp-D, Lp-Q, Lp-Rp, Ls-Rs, Ls-D, Ls-Q, R-X, G-B等；16.测试夹具盒一个：三同轴电缆4根，SMA电缆2根。17.具备自测试、自校准及诊断能力；18.高温等于或优于200度；19.探针微调行程等于或优于20mm，精度等于或优于1um。注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。 |

标的名称：荧光光谱仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  序号 |  参数性质 |  技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.氙灯150W，寿命≥2000小时2.光谱范围等于或优于200-980nm；3.汞灯校正，以汞灯校准波长，确保长期波长稳定性；4.信噪比水拉曼等于或优于1400：1（需要提供彩页，官网截图等佐证材料）；5.光谱分辨率等于或优于2nm；6.光谱带宽调节1nm，2nm，5nm，10nm，20nm；7.波长精确度等于或优于2nm；8.波长重复性等于或优于0.3nm；9.帕尔贴控温范围覆盖0-100℃；10.吸收光谱测试范围等于或优于190-900nm。注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。 |